

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ им. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
(УФирЭ им. В.А. Котельникова РАН)

Гончарова ул., д. 48/2, г. Ульяновск, 432011
Тел/факс 8(8422)44-29-96, ufire@mv.ru, <http://www.ulireran.ru>
ОКПО 12546744, ОГРН 1027700183708, ИНН/КПП 7703053425/732502001

18.11.2019. № УЧФ 11210 - 121
[Согласие выступить ведущей организацией]

Председателю диссертационного совета
Д 212.268.04., созданного на базе Томского
государственного университета систем
управления и радиоэлектроники
д.ф.-м.н., проф. Шандарову С.М.
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 40

Уважаемый Станислав Михайлович!

Настоящим письмом Ульяновский филиал Федерального бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук выражает свое согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Старосека Данила Геннадьевича на тему «Стабилизация теплового и электрического режимов в нитевидных модулях светоизлучающих GaN/InGaN диодов» по научной специальности 01.04.04 – Физическая электроника (технические науки).

Прилагаю к письму сведения об организации и список основных публикаций по научной специальности 01.04.04 – Физическая электроника (технические науки) в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет.

С уважением,
Директор УФирЭ им. В.А. Котельникова РАН,
д.т.н., профессор



В.А. Сергеев

Сведения о ведущей организации

по диссертации Старосека Данила Геннадьевича

«Стабилизация теплового и электрического режимов в нитевидных модулях
светоизлучающих GaN/InGaN диодов» по специальности 01.04.04 – Физическая электроника
на соискание ученой степени кандидата технических наук

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Ульяновский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН
Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Почтовый адрес организации	432071, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 48/2
Веб-сайт	http://ulireran.ru/
Телефон	(8422) 44-29-96
Адрес электронной почты	ufire@mv.ru

Список

основных научных работ сотрудников ведущей организации
по специальности 01.04.04 – Физическая электроника

№ п/п	Полное библиографическое наименование публикации
1.	Сергеев В.А. Связь уровня фототока светоизлучающих InGaN/GaN-гетероструктур с уровнем НЧ-шума и порогового тока / В.А. Сергеев, И.В. Фролов, О.А. Радаев // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2019. – Т. 24. – № 1. – С. 92–96.
2	Sergeev V.A. Thermoelectric model of the InGaN/GaN light emission diode with allowance for the substrate heterostructure effect / V.A. Sergeev, A.M. Hodakov // Russian Microelectronics. – 2018. – V. 47, № 7. – pp. 1-4.
3	Smirnov V.I. Measurement of the thermal impedance of light-emitting diodes and light-emitting diode matrices / V.I. Smirnov, V.A. Sergeev, A.A. Gavrikov // Measurement Techniques. – 2017. – Vol. 60, No. 1. – pp. 46-51.
4	Стойкость гетеропереходного светоизлучающего прибора к воздействию СВЧ излучения / В.Л. Веснин, В.А. Сергеев, А.М. Ходаков, И.В. Фролов // Журнал радиоэлектроники. – 2018. – № 8. – С. 7.
5	Sergeev V.A. Measurement of thermal parameters of digital integrated circuits on change of frequency of ring generators / V.A. Sergeev, Y.G. Tetenkin // Measurement Techniques. – 2018. – Vol. 61, No. 2. – pp. 154-160.
6	Фролов И.В. Динамические характеристики и квантовая эффективность отдельных спектральных составляющих спектра излучения InGaN светодиодов / И.В. Фролов, О.А. Радаев, В.А. Сергеев // Журнал радиоэлектроники. – 2018. – № 9. – С. 6.
7	Смирнов В.И. Измерение теплового сопротивления солнечных модулей модуляционным методом / В.И. Смирнов, В.А. Сергеев, А.А. Гавриков // Журнал радиоэлектроники. – 2018. – № 8. – С. 6.

8	Frolov I.V. Degradation of green InGaN-based LEDs during the tests at the constant current / I.V. Frolov, O.A. Radaev, V.A. Sergeev // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – Vol. 917. – P. 052017.
9	Сергеев В.А. Оценка адекватности тепловой модели КМОП цифровых интегральных схем по переходным тепловым характеристикам / В.А. Сергеев, Я.Г. Тетенькин // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 350-360.
10	Сергеев В.А. Определение тепловых параметров цифровых микросхем по температурным зависимостям времени задержки сигнала / В.А. Сергеев, Я.Г. Тетенькин // Автоматизация процессов управления. - 2015. – № 3 (41). – С. 89-97.
11	Sergeev V.A. Measuring complex for the diagnostics of the quality of light-emitting heterostructures according to photoelectric and optical responses under local photoexcitation / V.A. Sergeev, S.V. Vasin, I.V. Frolov, O.A. Radaev // Measurement Techniques. – 2018. – Vol. 61, No. 9. – pp. 914–920.
12	Ходаков А.М. Оценка в рамках теплоэлектрической модели стойкости светодиода к воздействию периодической последовательности СВЧ импульсов / А.М. Ходаков, В.А. Сергеев // Журнал радиоэлектроники. – 2017. – № 10. – С. 13.
13	Ходаков А.М. Теплоэлектрические процессы в гетеропереходном светоизлучающем диоде при воздействии на него мощного импульсного СВЧ излучения / А.М. Ходаков, В.А. Сергеев, А.А. Гавриков // Журнал радиоэлектроники. – 2017. №3. – С. 9.
14	Sergeev V.A. The relationship between the defectness of emitting nanoheterostructures of green InGaN/GaN LEDs and their threshold current values / V.A. Sergeev, I.V. Frolov, O.A. Radaev // Technical Physics Letters. – 2017. – Vol. 43, No. 2. – С. 224-226.
15	Теплоэлектрическая модель светоизлучающего диода при воздействии на него периодической последовательности СВЧ импульсов / А.М. Ходаков, В.А. Сергеев, А.А. Гавриков, А.М. Низаметдинов // Радиоэлектронная техника. – 2017. – № 1 (10). – С. 64-68.
16	Smirnov V.I. Modulation method for measuring thermal impedance components of semiconductor devices / V.I. Smirnov, V.A. Sergeev, A.A. Gavrikov, A.M. Shorin // Microelectronics Reliability. – 2018. – Vol. 80. – С. 205-212.
17	Сергеев В.А. Динамическая теплоэлектрическая модель светоизлучающей структуры со слоем растекания тока / В.А. Сергеев, А.М. Ходаков // Физика и техника полупроводников. – 2016. – Т. 50, № 8. – С. 1100-1105.
18	Radaev O.A. Photoelectric diagnostics of InGaN-based LEDs in static and dynamic modes / O.A. Radaev, I.V. Frolov, V.A. Sergeev // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – V. 917. – P. 052024.

С уважением,
 Директор УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН,
 д.т.н., профессор

В.А. Сергеев